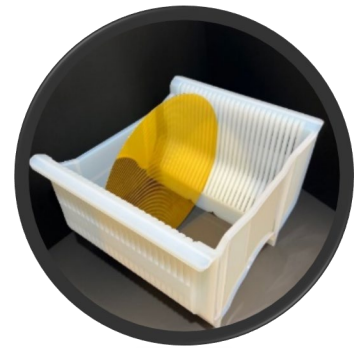


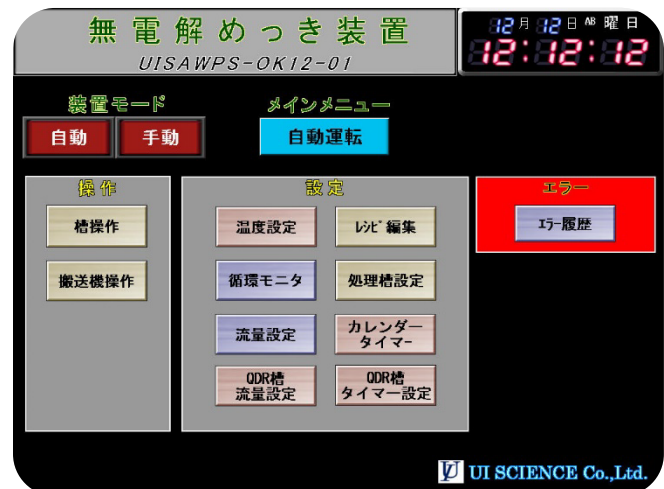
FULL AUTO PLATING SYSTEM for UBM
全自動無電解めっきシステム
: MODEL ELPS-UBM



- Waferサイズ 6、8、12インチ 対応
- 各種プロセスに対応(Ni-P/Pd/Au、Ni-P/Au)
- 噴流・攪拌による優良なウエハー膜厚分布
- 素材:Si、SiC、GaO、GaNなどのパワー半導体
- 25枚フルキャリア 2列搬送対応 月産1万枚以上
- クリーンルーム/クラス1000対応



- 12インチ25枚/フルキャリア対応
- 生産監視自動録画システム搭載
- 生産管理システム搭載
- 生産レシピ登録、読出、
- 薬液投入、洗浄機能 全自動対応
- 各薬液槽、高精度温度制御95°C~40°C±1°C
- 石英ガラス槽、SUS鏡面槽-自動開閉蓋搭載



自動								手動		自動運転	
#8 シンケツ1	#7 デスマット	#6 デスマット予備	#5 QDR	#4 表面調整	#3 QDR	#2 脱脂	#1 ロード (開始)				
12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	OFF			
12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3				
12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3				
#15 QDR	#14-2 Ni-2	#14-1 Ni-1	#13 QDR	#12 シンケツ2	#11 QDR	#10 Zn処理	#9 QDR				
12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0				
12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3				
12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3				
#20 ウェーブ (完了)	#19 QDR	#18 Au	#17 QDR	#16 Pd							
OFF	12.0	12.0	12.0	12.0							
12.3	12.3	12.3	12.3	12.3							
12.3	12.3	12.3	12.3	12.3							

Technical Spec	
ウエハ サイズ	150-200-300mm
ウエハ タイプ	Notch / Flat
ウエハ 厚み	200μm to >6mm
ウエハ 材質	Silicon GaAs GaN on Si, GaN on Sapphire Sapphire Transparent substrates and more
タンク数	13~18ステージ(QDR含む)
装置サイズ8C	W2300 × 約L16000 × H2500 (mm)
制御盤サイズ	W500 × L2000 × H2000 (mm)
電源	220V 3P 400A
めっきタンク容量	220ℓ-330ℓ
温度制御	±2°C
整流器電源容量	---
流量コントロール	25 lpm
めっき速度	>0.3μm/minute,
ウエハ膜厚均一性	<10% (range 2*mean)
ウエハ間膜厚均一性	<10% (mean-to-mean)
対応電流値	---
平面性	<5%
通信仕様	Ethernet and CC Link

UI SCIENCE CO.,LTD

1059-5 TAKATA KASHIWA CTIY CHIBA JAPAN 〒277-0861
 TEL 04-7137-7383 FAX 04-7137-7384
 e-mail s_umemoto@ui-science.co.jp
<http://www.ui-science.co.jp/>